

Васильев В. В., Дворецкий С. А., Варавин В. С., Михайлов Н. Н., Марчишин И. В., Сидоров Ю. Г., Сусялков А. О., Овсяк В. Н., Бурмасов В. С., Попов С. С., Кругляков Э. П., Асеев А. Л. СВЧ-детектор на основе КРТ-фотодиода для исследования субтермоядерной плазмы.	5
Васильев В. В., Дворецкий С. А., Варавин В. С., Михайлов Н. Н., Ремесник В. Г., Сидоров Ю. Г., Сусялков А. О., Асеев А. Л. Матричный фотоприемник на основе варизонного изотипного P - p -перехода в слоях КРТ, выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии.	17
Ли И. И., Базовкин В. М., Валишева Н. А., Гузев А. А., Ефимов В. М., Ковчавцев А. П., Курышев Г. Л., Половинкин В. Г., Строганов А. С., Царенко А. В. Многоэлементные гибридные ИК ФПУ на основе приборов с зарядовой инжекцией. Ч. I. Принципы считывания сигналов.	25
Ли И. И., Базовкин В. М., Валишева Н. А., Гузев А. А., Ефимов В. М., Ковчавцев А. П., Курышев Г. Л., Половинкин В. Г., Строганов А. С., Царенко А. В. Многоэлементные гибридные ИК ФПУ на основе приборов с зарядовой инжекцией. Ч. II. Тепловизионные системы с элементами на InAs.	36
Базовкин В. М., Валишева Н. А., Гузев А. А., Ефимов В. М., Ковчавцев А. П., Курышев Г. Л., Ли И. И., Половинкин В. Г., Строганов А. С. Быстродействующий ИК-спектрограф (0,5–3,0 мкм) на основе гибридного модуля 1×384 InAs. .	50
Ли И. И. Устройство считывания для ИК ФПУ с режимом временной задержки и накопления.	56
Акимов А. Н., Климов А. Э., Шумский В. Н., Асеев А. Л. Матричные фотоприемные устройства субмиллиметрового диапазона на основе пленок $\text{PbSnTe} : \text{In}$	63
Козлов А. И., Марчишин И. В., Овсяк В. Н. Кремниевые мультиплексоры 320×256 для инфракрасных фотоприемных устройств на основе КРТ-диодов.	74
Ярцев А. В. Особенности адмиттанса МДП-структур на основе слоев КРТ, полученных методом молекулярно-лучевой эпитаксии.	83
Овсяк В. Н., Ярцев А. В. Обратный ток p - n -переходов с полевым электродом на основе гетерозиптаксиальных структур CdHgTe/GaAs	89
Ефимов В. М., Есаев Д. Г. Метод определения критического давления при сборке гибридных фотоприемных устройств на основе КРТ.	98

НАНОТЕХНОЛОГИИ В ОПТИКЕ И ЭЛЕКТРОНИКЕ

- Дворецкий С. А., Икусов Д. Г., Квон Д. Х., Михайлов Н. Н., Дай Н., Смирнов Р. Н., Сидоров Ю. Г., Швец В. А. Выращивание квантовых ям $\text{HgTe}/\text{Cd}_{0,735}\text{Hg}_{0,265}\text{Te}$ методом молекулярно-лучевой эпитаксии. 104
- Есаев Д. Г., Марчишин И. В., Овсяк В. Н., Савченко А. П., Фатеев В. А., Шашки В. В., Сухарев А. В., Падалица А. А., Будкин И. В., Мармалюк А. А. Инфракрасное фотоприемное устройство на основе многослойных структур $\text{GaAs}/\text{AlGaAs}$ с квантовыми ямами. 112